УДК 666.1.05

А. А. Шрам

Запорожский национальный технический университет

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА

В статье разработана математическая модель ионно-плазменной модификации поверхности стекла при атмосферном давлении.

Ключевые слова: плазма, математическая модель, поверхностная модификация, стекло, ионно-плазменная обработка.

Введение модифицирующих элементов в поверхностный слой стекла позволяет повысить его эксплуатационные свойства, механическую прочность, обеспечить регулирование оптических свойств, а также получить возможность окрашивания стекла в различные цвета.

Качество модифицированного поверхностного слоя стекла зависит от таких параметров, как вид исходного материала внедрения, состав обрабатываемого стекла, расход и вид плазмообразующего газа, геометрических и энергетических параметров плазмотрона.

Возможность предварительного определения оптимальных диапазонов изменения технологических параметров процесса для обеспечения внедрения элементарных частиц модифицирующего материала (атомов и ионов) и равномерного их распределения в диффузионном слое приводит к снижению удельного расхода материала внедрения при формировании высококачественных проникающих покрытий на поверхности стекла с одновременным повышением производительности процесса обработки.

Распределение температуры T(r) в сечении цилиндрического дугового столба описывается уравнением баланса энергии, известным как уравнение Эленбааса-Хеллера [1–3]:

$$-\frac{1}{r}\left(\frac{d}{dr}r\lambda\frac{dT}{dr}\right) = \sigma E^2 - \psi, \qquad (1)$$

где напряженность электрического поля $E=E_z(r)=$ const имеет только аксиальную составляющую, не зависящую от радиальной координаты. Уравнение (1) описывает установившийся процесс, при котором выделяющееся джоулево тепло σE^2 за вычетом потерь на излучение Ψ переносится к охлаждаемым стенкам теплопроводностью.

Необходимые для решения задачи свойства плазмы λ , σ , Ψ при постоянном давлении являются функциями только температуры [1–3]. Реальные зависимости $\lambda(T)$, $\sigma(T)$, $\psi(T)$ (рис. 1) существенно нелинейные,



Рис. 1. Зависимости теплопроводности λ и теплового потенциала θ воздуха от температуры

что затрудняет аналитическое рассмотрение (1). Его вид можно несколько упростить известным приемом введения новой независимой переменной – потенциала теплового потока (рис. 1)

$$\theta = \int_{0}^{T} \lambda(T) dT , \qquad (2)$$

являющегося при *p* = const однозначной функцией температуры.

При этом уравнение (1) записывается следующим образом:

$$d\theta = \lambda(T)dT$$

$$-\frac{1}{r}\left(\frac{d}{dr}r\frac{d\theta}{dr}\right) = \sigma(\theta)E^2 - \psi(\theta).$$
(3)

Полный ток дуги *I* определяется интегральным законом Ома

$$I = 2\pi E \int_{o}^{R} \sigma r dr \,. \tag{4}$$

Каналовая модель Штеенбека-Райзера основана на сильной зависимости электрической проводимости плазмы от температуры [3, 4]. При температурах ниже 3000 К $\sigma(T) = 0$ и существенно возрастает при температурах выше 4000 К. Таким образом электрическую дугу можно представить в виде двух областей – проводящей и непроводящей (рис. 2).

Нелинейная зависимость электропроводности от функции теплопроводности представляется в виде

$$\sigma(\theta) = \begin{cases} b^2(\theta - \theta_*) & \text{для } \theta_* < \theta < \theta_0; \\ 0 & \text{для } \theta < \theta_*, \end{cases}$$

где b – постоянная; θ_0 – максимальное значение θ (на оси); θ_* – значение на границе зоны проводимости плазмы.

Благодаря этой аппроксимации сечение канала разбивается на две области: область проводимости ($\sigma \neq 0$) и непроводящую область ($\sigma = 0$).

В области проводимости уравнение (3) принимает следующий вид.

Введем переменную

$$x = rE\sqrt{b}$$
, $dx = E\sqrt{b}dr$, $dr^2 = \frac{dx^2}{E^2 \cdot b}$.

$$E^2 \cdot b \frac{d^2 \theta_I}{dx^2} + \frac{(E\sqrt{b})^2}{x} \frac{d \theta_I}{dx} + E^2 \cdot b \cdot (\theta_I - \theta_*) = 0,$$

$$\frac{d^2\theta_I}{dx^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d\theta_I}{dx} + (\theta_I - \theta_*) = 0.$$
 (5, a)

В непроводящей области уравнение (3) преобразуется в

$$\frac{1}{r} \left(\frac{d}{dr} r \frac{d\theta_{II}}{dr} \right) = 0.$$
 (5, 6)



Рис. 2. Каналовая модель электрической дуги

ISSN 1607-6761

Общее решение уравнения (5, δ) можно представить в виде

$$\theta_{II} = C_1 + C_2 \cdot \ln |r|.$$

Используя граничные условия

$$\theta_I(0) = \theta_0, \frac{d\theta_I}{dr}\Big|_{r=0} = 0;$$

$$\theta_{II}(R) = 0, \ \theta_{II}(r_0) = \theta_*,$$

получаем $C_1 = -C_2 \cdot \ln |R|$,

$$\theta_I = -C_2 \cdot \ln |R| + C_2 \cdot \ln |r_*| \qquad \Rightarrow \qquad C_2 = \frac{\theta_*}{\ln \frac{r_*}{R}}$$

$$\theta_{II}(r) = -\frac{\theta_*}{\ln\left|\frac{r_*}{R}\right|} \cdot \ln\left|R\right| + \frac{\theta_*}{\ln\left|\frac{r_*}{R}\right|} \cdot \ln\left|r\right| \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \theta_{II}(r) = \theta_* \cdot \frac{\ln \left| \frac{r}{R} \right|}{\ln \left| \frac{r_*}{R} \right|}.$$

Решением уравнения (5, *a*) является функция Бесселя первого рода нулевого порядка. С учетом граничных условий решение можно записать в виде:

$$\theta_I(r) = \theta_* + (\theta_0 - \theta_*) \cdot J_0(x),$$

где $J_0(x)$ – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Таким образом, решения уравнения (3) в проводящей и непроводящей области записываются в следующем виде:

$$\hat{\theta}_{I}(r) = \theta_{*} + (\theta_{0} - \theta_{*}) \cdot J_{0}(x)$$
$$\theta_{II}(r) = \theta_{*} \cdot \frac{\ln \left| \frac{r}{R} \right|}{\ln \left| \frac{r_{*}}{R} \right|}.$$

Учитывая, что диаметр проводящей области электрической дуги намного меньше диаметра разрядного канала, распределение температуры на срезе сопла плазмотрона можно записать в виде:

$$T(r) = T_m \cdot \left(\ln \frac{r}{r_0} \right)^{1/n+1}$$

Температура на оси столба электрической дуги определяется [3]:

$$T_m = \sqrt{\omega \cdot \frac{I_i}{8\pi\lambda_m}} \; .$$

Температура *T* по оси турбулентной струи определяется следующей зависимостью [5]:

n...

$$\frac{T-T_{\infty}}{T_m-T_{\infty}} = \left[\left[1 - \left(\frac{z}{Z_m}\right)^{1.5} \right]^2 \right]^{\Gamma_T},$$

где T_m – осевое значение температуры на срезе сопла плазмотрона; T_{∞} – температура окружающей среды, $T_{\infty} = 300 \text{ K}$; Z_m – ордината внешней границы струи; \Pr_r – турбулентное число Прандтля, для осесимметричных струй $\Pr_r = 0,8$.

Процесс накопления диффундирующего вещества в различных точках среды как функцию времени описывает второй закон Фика:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

где *D* – коэффициент диффузии, *с* – концентрация диффундирующего вещества, *х* – координата.

Для диффузии в полубесконечное твердое тело:

$$c(x,t) = \frac{c_0}{\sqrt{\pi \cdot D \cdot t}} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{4 \cdot D \cdot t}\right),$$

где c – концентрация диффундирующего вещества при данных t и x; c_0 – концентрация вещества при t=0 и x=0.

Зависимость коэффициента диффузии атомов и ионов меди от температуры описывается следующим выражением [6]:

$$D_{\rm Cu} = 1.91 \cdot 10^{-2} \cdot \exp\left(-\frac{27000}{R \cdot T}\right)$$

Для определения температурного поля и теплового потока при стационарной теплопроводности рассмотрим поверхность стекла как однородную плоскою стенку толщиной δ .

Стенка имеет одинаковый по всей толщине коэффициент теплопроводности λ_{cT} . Температура на границах стенки – T_{w1} и T_{w2} , а изотермические поверхности имеют форму плоскостей, параллельных поверхностям стенки.

При рассматриваемых условиях тепло может распространяться только вдоль оси *x*, и температурное

поле будет одномерным. Температурные градиенты вдоль остальных осей координат равны нулю, следовательно,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$$

С учетом этого дифференциальное уравнение теплопроводности для плоской стенки будет иметь вид

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$$

$$\begin{cases} T(r) = T_m \cdot \left(\ln \frac{r}{r_0} \right)^{1/n+1}, \\ T_m = \sqrt{\omega \cdot \frac{I_i}{8\pi\lambda_m}}, \\ \frac{T - T_\infty}{T_m - T_\infty} = \left[\left[1 - \left(\frac{z}{Z_m} \right)^{1.5} \right]^2 \right]^{\Pr_T}, \\ c(x,t) = \frac{c_0}{\sqrt{\pi \cdot D \cdot t}} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{4 \cdot D \cdot t} \right)^2 \\ D_{Cu} = 1.91 \cdot 10^{-2} \cdot \exp\left(-\frac{27000}{R \cdot T} \right)^2 \\ \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0. \end{cases}$$

Решение полученной системы уравнений позволяет установить связь между технологическими характеристиками процесса плазменной модификации поверхности стекла (величиной тока, геометрическими размерами разрядной камеры, теплофизическими свойствами материала внедрения) и распределением материала внедрения в поверхностном слое обработанного изделия.

Концентрация материала внедрения в поверхностном слое стекла описывается следующим уравнением:

$$c(x,t) = \frac{c_0}{\sqrt{\pi \cdot 1.91 \cdot 10^{-2} \cdot \exp\left(-\frac{27000}{R \cdot T(r)}\right) \cdot t}} \times \exp\left(-\frac{x^2}{4 \cdot 1.91 \cdot 10^{-2} \cdot \exp\left(-\frac{27000}{R \cdot T(r)}\right) \cdot t}\right)$$

$$T(r) = T_m \cdot \left(\ln \frac{r}{r_0} \right)^{1/n+1}$$

Профили температуры плазменного потока представлены на рис. 3, 4. Распределение материала внедрения в поверхностном слое стекла показано на рис. 5 (время обработки t = 20 сек).

Разработанная математическая модель ионно-плазменной модификации поверхности стекла позволяет установить связь технологических параметров ионноплазменного процесса с характеристиками поверхности обработанных изделий и выбрать оптимальные диапазоны изменения рабочих параметров процесса.



Рис. 3. Профили температуры плазменного потока при работе плазмотрона на воздухе:1 – Z = 10 мм, G = 0.0021 кг/с; 2 – Z = 30 мм, G = 0.0021 кг/с; 3 – Z = 50 мм, G = 0.0021 кг/с; 2 – Z = 70 мм, G = 0.0021 кг/с.



Рис. 4. Температурное поле плазменного потока на срезе сопла плазмотрона



Рис. 5. Распределение материала внедрения в поверхностном слое стекла (t = 20 сек)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Теория столба электрической дуги / В. С. Энгельшт, В. И. Гурович, Г. А. Десятков и др. – Новосибирск : Наука, 1990. – 376 с.
- Физика и техника низкотемпературной плазмы / [С. В. Дресвин, А. В. Донской, В. М. Гольдфарб, В. С. Клубникин]; под общ. ред. С. В. Дресвина. – М.: Атомиздат, 1972. – 352 с.
- 3. *Fridman, A.* Plasma chemistry/Alexander Fridman. New York: Cambridge University Press, 2008. – 978 p.
- Грановский, В. Л. Электрический ток в газе (установившийся ток) / В. Л. Грановский. М. : Наука, 1971. – 544 с.
- Петров, С. В. Плазменное газовоздушное напыление / С. В. Петров, И. Н. Карп. – К.: Наук. думка, 1993. – 495 с.
- Евстропьев, К. К. Диффузионные процессы в стекле / К. К. Евстропьев. – Л.: Стройиздат. – 1970. – 168 с.

Стаття надійшла до редакції 25.06.2011.

Шрам О. А.

Математична модель іонно-плазмової модифікації поверхні скла

У статті розроблено математичну модель іонно-плазмової модифікації поверхні скла при атмосферному тиску.

Ключові слова: плазма, математична модель, поверхнева модифікація, скло, іонно-плазмова обробка.

Shram A. A.

Mathematical model of glass surface ion-plasma modification

The paper describes the mathematical model of glass surface ion-plasma modification at atmospheric pressure. *Keywords:* plasma, mathematical model, surface modification, glass, ion-plasma treatment.